

# IEC 60747-5-5

Edition 1.1 2013-05

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

colour inside

Semiconductor devices – Discrete devices – Part 5-5: Optoelectronic devices – Photocouplers

Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets – Partie 5-5: Disposițifs optoelectroniques – Photocoupleurs

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ICS 31.080.01; 31.260

ISBN 978-2-8322-0814-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

 Registered trademark of the International Electrotechnical Commission Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
 – 2 –

60747-5-5 © IEC:2007+A1:2013

# CONTENTS

FC	REW	ORD		6	
1	Scop	e		8	
2	Norm	Normative references			
3	Photocoupler				
Ũ	3.1 Somiconductor material		anductor material	۰ ۵	
	3.1	Details	of outline and encansulation	وع م	
	0.2	3 2 1	IFC and/or national reference number of the outline drawing	۰ ۹	
		322	Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other	9	
		3.2.3	Terminal identification and indication of any connection between a		
	<u> </u>	Tuna a	terminal and the case	9	
	3.3	1ype o	DC input photocoupler	9	
		3.3.1 3.3.2	AC input photocoupler	9	
		333	Phototransistor photocoupler	9	
		331	Photodarlington photocoupler	9	
		335	Photothyristor photocoupler	9 Q	
		336	Phototriac photocouplet	10	
		337	IC photocoupler	10	
		3.3.8	FET photocoupler		
		3.3.9	Photodiode photocoupler		
		3.3.10	IC input photocoupler		
		3.3.11	Solid state opto relay		
4	Term	ns relate	d to ratings and characteristics for photocouplers		
	4.1	Curren	t transfer ratio		
		4.1.1	Static value of the (forward) current transfer ratio h <sub>E(ctr)</sub>		
		4.1.2	Small-signal short-circuit (forward) current transfer ratio hf(ctr)		
	4.2	Cut-off	frequency for		
	4.3	Input-t	e-output capacitance C <sub>IO</sub>		
	4.4	Isolatio	on resistance R <sub>IO</sub>		
	4.5 <	Isolatic	on voltage	10	
		4.5.1	DC isolation voltage V <sub>IO</sub>	11	
		4.5.2	Repetitive peak isolation voltage VIORM	11	
		4.5.3	Surge isolation voltage V <sub>IOSM</sub>	11	
	4.6	Terms opto-re	related to photocouplers with phototriac output and/or solid state alay with triac output	11	
		4.6.1	Repetitive peak voltage	11	
		4.6.2	Repetitive peak off-state voltage V <sub>DRM</sub>	11	
		4.6.3	Repetitive peak reverse voltage V <sub>RRM</sub>	11	
		4.6.4	RMS on-state current / <sub>T(RMS)</sub>	11	
		4.6.5	Peak off-state current IDRM	11	
		4.6.6	Peak on-state voltage V <sub>TM</sub>	11	
		4.6.7	DC off-state current I <sub>BD</sub>	11	

- 3 -

		4.6.8	DC on-state voltage V <sub>T</sub>	.11
		4.6.9	Holding current <i>I</i> <sub>H</sub>	. 11
		4.6.10	Critical rate of rise of off-state voltage dV/dt	.11
		4.6.11	Trigger input current / <sub>FT</sub>	. 12
	4.7	Commo	on mode transient immunity CMTI	. 12
5	Term	s for ph	otocoupler providing protection against electrical shock	.12
	5.1	Safety	ratings of a photocoupler for reinforced isolation	. 12
	5.2	Electric	cal safety requirements of a photocoupler for reinforced isolation	. 12
		5.2.1	Partial discharge p <sub>d</sub>	. 12
		5.2.2	Apparent charge $q_{\text{pd}}$ , $q$	. 12
		5.2.3	Threshold apparent charge $q_{pd(TH)}$ , $q_{TH}$	. 12
		5.2.4	Test voltages for the partial-discharge test of a photocoupler	. 12
		5.2.5	Test voltage V <sub>pd(t)</sub> , V <sub>t</sub>	. 12
		5.2.6	Partial discharge test voltage V <sub>pd(t)</sub>	. 13
		5.2.7	Initial test voltage V <sub>pd(ini)</sub> , V <sub>ini</sub>	. 13
		5.2.8	Apparent charge measuring voltage V <sub>pd(m)</sub> , Vm	. 13
		5.2.9	Partial-discharge inception voltage V	. 13
		5.2.10	Partial-discharge extinction voltage Vpd(e), Ve	. 13
		5.2.11	Time intervals of the test voltage	. 13
	5.3	Isolatio protect	n voltages and isolation test voltages for photocouplers providing ion against electrical shock	. 16
		5.3.1	Rated isolation voltage	. 16
	5.4	Limiting	g values (absolute maximum system) over the operating temperature unless otherwise stated	. 16
		5.4.1	Minimum and maximum storage temperatures T <sub>sta</sub>	. 16
		5.4.2	Minimum and maximum ambient or reference-point operating temperatures $T_{amb}$ or $T_{ref}$	. 16
		5.4.3 🗸	Maximum soldering temperature T <sub>eld</sub>	. 16
		5.4.4	Maximum continuous (direct) reverse input voltage V <sub>R</sub>	. 16
		5.4.5	Maximum collector-emitter voltage, with the base open-circuited	
		•	VCEO	. 16
		5.4.6	Maximum collector-base voltage, where an external base connection is present, with the emitter open-circuited V <sub>CBO</sub>	. 16
	<	5.4.7	Maximum emitter-base voltage, where an external base connection is present, with the collector open-circuited V <sub>EBO</sub>	. 16
		5.4.8	Maximum emitter-collector voltage, where no external base connection is present $V_{FCO}$ .	. 16
		5.4.9	Maximum continuous (direct) or repetitive peak isolation voltage $V_{IO}$ or $V_{IORM}$	. 16
		5.4.10	Where appropriate, maximum surge isolation voltage $V_{\rm IOSM}$	. 16
		5.4.11	Maximum continuous collector current <i>I</i> <sub>C</sub>	. 17
		5.4.12	Maximum continuous forward input current $I_F$ at an ambient or reference-point temperature of 25 °C and derating curve or derating factor.	. 17
		5.4.13	Maximum peak forward input current $I_{FM}$ at an ambient or reference-point temperature of 25 °C and under specified pulse conditions	. 17

- 4 -

60747-5-5 © IEC:2007+A1:2013

		5.4.14	Maximum power dissipation $P_{\rm trn}$ of the output transistor at an ambient or reference-point temperature of 25 °C and a derating curve or derating factor	17
		5.4.15	Maximum total power dissipation of the package $P_{tot}$ at an ambient or reference-point temperature of 25 °C and derating curve or derating	47
e	Floot	rical ab		/
0	Elect			17
	6.1	Phototi	ransistor output photocoupler	17
_	6.2	Phototi	riac output photocoupler or solid state opto-relay	19
7	Phote	ocouple	rs providing protection against electrical shock	19
	7.1	Туре		19
	7.2	Ratings sheet).	s (have to be mentioned in a special section in the manufacturer's data	19
		7.2.1	Safety ratings	19
		7.2.2	Functional ratings	19
		7.2.3	Rated isolation voltages	19
	7.3	Electric	cal safety requirements	20
	7.4	Electric	cal, environmental and/or endurance test information (supplementary ation)	20
8	Meas	uring m	ethods for photocouplers	27
	8.1	Curren	t transfer ratio heretry	27
	8.2	Input-te	p-output capacitance	28
	8.3	Isolatio	on resistance between input and output Ric	29
	8.4	Isolatic	on test	30
	8.5	Partial	discharges of photocouplers	31
	8.6	Collect	or-emitter saturation voltage $V_{CE}$ of a photocoupler	34
		8.6.1	Collector-emitter saturation voltage (d.c. method)	34
		8.6.2	Collector-emitter saturation voltage (pulse method)	35
	8.7	Switch	ing times ton toff of a photocoupler	36
	8.8	Peak o	ff-state current I pp	37
	8.9	Peak o	n-state voltage VTM	39
	8.10	DC off	state current IBD	41
	8.11	DC on-	state voltage VT	42
	8.12	Holding	g ourcent ) H	43
	8.13	Critical	rate of rise of off-state voltage dV/dt	43
	8.14	Trigger	input current / <sub>FT</sub>	46
	8.15	Measu	ring methods of common mode transient immunity (CMTI) for oupler	47
9	Testi	na meth	ods of electrical rating for phototriac coupler	49
	<b>9</b> 1	Repetit		49
	9.2	DC off-	state voltage VDRM	50
	0.2	5001		
Anr	nex A	(normat	ive) Input/output safety test	51
Bib	liogra	ohy		52

Figure 1a – Time intervals for method a)	14
Figure 1b – Time intervals for method b)	15
Figure 1 – Time intervals of the test voltage	
Figure 2 – Test voltage	17
Figure 3 – Measurement circuit	27
Figure 4 – Measurement circuit for input to output capacitance	29
Figure 5 – Measurement circuit for isolation resistance	29
Figure 6 – Test circuit for withstanding isolation voltage	
Figure 7 – Partial discharge test circuit	31
Figure 8 – Complete test arrangement connections for calibration	32
Figure 9 – DC measurement circuit	
Figure 10 – Pulse measurement circuit	35
Figure 11 – Switching time measurement circuit	
Figure 12 – Switching times	
Figure 13 – Measurement circuit for peak off-state current	
Figure 14 – Waveforms of the peak off-state voltage and current	
Figure 15 – Measurement circuit for peak on-state voltage	40
Figure 16 – Waveforms of the peak on-state voltage and current	41
Figure 17 – Measurement circuit for d.c. off-state current	41
Figure 18 – Measurement circuit for d.c. on-state voltage	42
Figure 19 – Measurement circuit for holding current	43
Figure 20 – Measurement circuit for critical rate of rise of off-state voltage	44
Figure 21 - Exponential waveform of the off-voltage (VD)	45
Figure 22 –Linear pulse form of the off-voltage (VD)	45
Figure 23 – Measurement circuit for the trigger input current	46
Figure 24 - Output terminal voltage versus input forward current	46
Figure 25 – Common mode transient immunity (CMTI) measurement circuit for photocoupler	47
Figure 26 – Typical waveforms of the common mode pulse ( $V_{CM}$ ) and optocoupler output ( $V_{O}$ )	49
Figure A.1 – Circuit diagram	51
Table 1 – Datasheet characteristics	20
Table 2 – Tests and test sequence for photocoupler providing protection against electrical shock	26
Table 3 – Test conditions	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 6 -

60747-5-5 © IEC:2007+A1:2013

#### INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

#### SEMICONDUCTOR DEVICES – DISCRETE DEVICES –

### Part 5-5: Optoelectronic devices – Photocouplers

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this and and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

# This consolidated version of IEC 60747-5-5 consists of the first edition (2007) [documents 47E/332/FDIS and 47E/340/RVD] and its amendment 1 (2013) [documents 47E/437/CDV and 47E/451/RVC]. It bears the edition number 1.1.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has been prepared for user convenience. A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendment 1. Additions and deletions are displayed in red, with deletions being struck through.

International Standard IEC 60747-5-5 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This standard replaces the clauses for photocouplers (or optocouplers) described in IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2 and IEC 60747-5-3, including their amendments.

The contents for phototransistors and photothyristors in IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2 and IEC 60747-5-3, including their amendments, will be considered obsolete as of the effective date of publication of this standard.

NOTE Photocouplers that are certified to the previous version of the photocoupler standard, namely IEC 60747-5-1/2/3, are to be considered in compliance with the requirements and provisions of IEC 60747-5-5.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of the parts in the IEC 60747 series, under the general title Semiconductor devices – *Discrete devices*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the NEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this publication using a colour printer.

- 8 -

60747-5-5 © IEC:2007+A1:2013

#### SEMICONDUCTOR DEVICES – DISCRETE DEVICES –

# Part 5-5: Optoelectronic devices – Photocouplers

#### 1 Scope

This part of IEC 60747 gives the terminology, essential ratings, characteristics, safety tests as well as the measuring methods for photocouplers (or optocouplers).

NOTE The word "optocoupler" can also be used instead of "photocoupler".

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

IEC 60068-1:1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold

IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing - Rart 2: Tests - Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state

IEC 60068-2-6:--, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)<sup>1</sup>

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-17: 1994 Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Q: Sealing

IEC 60068-2-27:—, Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock and bump<sup>2</sup>

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

IEC 60068-2-58:2005, Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To be published (replacing the sixth edition)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> To be published (replacing the third edition)

-9-

IEC 60216-1:2001, Electrical insulating materials – Properties of thermal endurance – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results

IEC 60216-2:2005, Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials – Choice of test criteria

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: *Principles, requirements and tests* 

IEC 60672-2:1999, Ceramic and glass insulating materials – Part 2: Methods of test

IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

– 54 –

60747-5-5 © CEI:2007+A1:2013

# SOMMAIRE

AV	ANT-F	PROPOS	3	58		
1	Dom	aine d'a	pplication	60		
2	Réfé	Références normatives				
3	Photocoupleur					
	2 4					
	3.I	Dáteila	au semi-conducteur	01		
	3.2		Au encomprement et encapsulation			
		3.2.1	dessin d'encombrement	61		
		3.2.2	Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre	61		
		3.2.3	Identification des bornes et indication de toute connexion entre une borne et le boîtier	61		
	3.3	Type d	e photocoupleurs	61		
		3.3.1	Photocoupleur à entrée en courant continu	61		
		3.3.2	Photocoupleur à entrée en courant alternatif	61		
		3.3.3	Photocoupleur à phototransistor	61		
		3.3.4	Photocoupleur à photodarlington	61		
		3.3.5	Photocoupleur à photothyristor	61		
		3.3.6	Photocoupleur à phototriac	62		
		3.3.7	Photocoupleur à Cl	62		
		3.3.8	Photocoupleur à TEQ	62		
		3.3.9	Photocoupleur à phototransistor	62		
		3.3.10	Photocoupleur à entrée à Cl	62		
		3.3.11	Relais optoélectronique statique	62		
4	Term	ies relat	ifs aux valeurs assignées et aux caractéristiques des photocoupleurs	62		
	4.1	Rappo	nt de transfert de courant	62		
		4.1.1	Valeur statique du rapport de transfert (direct) du courant h <sub>F(ctr)</sub>	62		
		4.1.2	Rapport du transfert (direct) du courant, la sortie étant en court-	62		
	4.2	Freque	ence de coupure foo	62		
	4.3 Capacità entrée sortie Cio					
	4.4 Résistance d'isplement Rio					
	4.5	Tensio	n d'isolement	62		
		4.5.1	Tension d'isolement en courant continu Vio	63		
		4.5.2	Tension d'isolement de pointe répétitive ViopM	63		
		4.5.3	Tension d'isolement de surcharge accidentelle VIOSM	63		
	4.6	Termes liés aux photocoupleurs avec en sortie un phototriac et/ou relais				
		4 6 1	Tension de crête répétitive	63		
		4.6.2	Tension de crête répétitive à l'état bloqué Voor	63		
		463	Tension inverse de crête répétitive Voca	63		
		4.6.4	Courant à l'état passant en valeur efficace /томе	63		
		4.6.5	Courant de crête à l'état bloqué / DDM	63		
		4.6.6	Tension de crête à l'état passant $V_{TM}$	63		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

		4.6.7	Courant à l'état bloqué continu IBD	63
		4.6.8	Tension continue à l'état passant $V_{T}$	63
		4.6.9	Courant de maintien I <sub>H</sub>	63
		4.6.10	Taux critique d'augmentation de tension à l'état bloqué dV/dt	63
		4.6.11	Courant d'entrée d'amorçage / <sub>FT</sub>	64
	4.7	Immun	ité transitoire en mode commun CMTI	64
5	Term élect	es pour riques	un photocoupleur concernant la protection contre les chocs	64
	5.1	Caracte	éristiques de sécurité d'un photocoupleur pour une isolation renforcée	64
	5.2 Exigo renfo		ces de sécurité électrique d'un photocoupleur pour une isolation	64
		5.2.1	Décharge partielle <i>p</i> <sub>d</sub>	64
		5.2.2	Charge apparente $q_{\text{pd}}$ , $q$	64
		5.2.3	Charge apparente de seuil q <sub>pd(TH)</sub> , q <sub>TH</sub>	64
		5.2.4	Tensions d'essai pour l'essai de décharge partielle d'un photocoupleur	64
		5.2.5	Tension d'essai V <sub>pd(t)</sub> , V <sub>t</sub>	64
		5.2.6	Tension d'essai pour l'essai de décharge partielle Vpd(t)	65
		5.2.7	Tension d'essai initiale V <sub>pd(ini)</sub> , V <sub>ini</sub>	65
		5.2.8	Tension de mesure de la charge apparente V <sub>pd(m)</sub> , V <sub>m</sub>	65
		5.2.9	Tension d'apparition de décharge partielle Vodity, Vi	65
		5.2.10	Tension d'extinction de décharge partielle Vpd(e), Ve	65
		5.2.11	Intervalles de temps de la tension d'essai	65
	5.3	Tensio protect	ns d'isolement et tensions d'essai d'isolement pour photocoupleurs de ion contre les chocs électriques	68
		5.3.1	Tensions d'isolement assignées	68
	5.4	Valeur: tempér	s limites (système des limites a <del>bs</del> olues) dans la gamme des atures de fonstionnement, sauf indication contraire	68
		5.4.1	Temperatures de stockage minimale et maximale T <sub>sta</sub>	68
		5.4.2	Températures de fonctionnement, ambiantes minimale et maximale ou d'un point de référence $T_{amb}$ ou $T_{ref}$	68
		5.4.3	Température maximale de soudage T <sub>sld</sub>	68
		5.4.4	Tension continue (directe) inverse maximale à l'entrée V <sub>R</sub>	68
	<	5.4.5	Tension collecteur-émetteur maximale, la base étant en circuit ouvert	68
		5.4.6	Tension collecteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base, l'émetteur étant en circuit ouvert V <sub>CBO</sub>	68
		5.4.7	Tension émetteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base, le collecteur étant en circuit ouvert $V_{\text{EBO}}$	68
		5.4.8	Tension émetteur-collecteur maximale, s'il n'existe pas de connexion externe de base $V_{\text{ECO}}$	68
		5.4.9	Tension maximale d'isolement continue (directe) ou de crête répétitive V <sub>IO</sub> ou V <sub>IORM</sub>	68
		5.4.10	S'il y a lieu, tension maximale d'isolement de surcharge $V_{\text{IOSM}}$	69
		5.4.11	Courant collecteur continu maximal <i>I</i> <sub>C</sub>	69
		5.4.12	Courant d'entrée direct continu maximal <i>I</i> <sub>F</sub> à une température ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction	
			ou facteur de réduction	69

- 56 -

# 60747-5-5 © CEI:2007+A1:2013

		5.4.13	Courant d'entrée direct de crête maximal <i>I</i> <sub>FM</sub> à une température ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et dans des conditions d'impulsions spécifiées	69
		5.4.14	Puissance dissipée maximale $P_{trn}$ du transistor de sortie à une température ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction	69
		5.4.15	Puissance dissipée totale maximale dans le boîtier <i>P</i> tot à une température ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction	69
6	Cara	ctéristiq	ues électriques	69
	6.1	Photoc	oupleur à phototransistor	69
	6.2	Photoc	coupleur de sortie à phototriac ou relais optoélectronique statique	71
7	Phote	ocouple	urs offrant une protection contre les chocs électriques	71
	7.1	Туре		71
	7.2	Valeur: fabrica	s assignées (à mentionner dans une section spéciale du catalogue de nt)	71
		7.2.1	Caractéristiques de sécurité	71
		7.2.2	Caractéristiques fonctionnelles	71
		7.2.3	Tensions d'isolement assignées	71
	7.3	Exigen	ces de sécurité électrique	72
	7.4	Informa (inform	ations sur des essais électriques, d'environnement et/ou d'endurance lations supplémentaires)	72
8	Méth	odes de	e mesure pour les photocoupleurs	79
	8.1	Rappo	rt de transfert de courant h <sub>E(ctr)</sub>	79
	8.2	Capaci	ité entrée-sortie C <sub>IQ</sub>	80
	8.3	Résista	ance d'isolement entre l'entrée et la sortie (R <sub>IO</sub> )	81
	8.4	Essai o	d'isolement	82
	8.5	Déchai	rges partielles des photocoupleurs	83
	8.6	Tensio	n de saturation collecteur-émetteur V <sub>CE(sat)</sub> d'un photocoupleur	86
		8.6.1	Tension de saturation collecteur-émetteur (méthode en courant	0.0
		060	Continu)	80
	87	Tomps	de commutation $t = t \ll d'un photocoupleur$	07
	8.8	Courar	the crôte à l'état bloqué loom	89
	8.9	Tensio	n de grête à l'état passant $V_{TM}$	91
	8.10	Courar	nt à l'état blogué continu (IBD)	93
	8.11	Tensio	n continue à l'état passant $V_{T}$	94
	8.12	Courar	nt de maintien (I <sub>H</sub> )	95
	8.13	Taux c	ritique d'augmentation de tension à l'état bloqué (d <i>V</i> /d <i>t</i> )	95
	8.14	Courar	nt d'entrée d'amorçage / <sub>FT</sub>	98
	8.15	Méthoo les pho	des de mesure de l'immunité transitoire en mode commun (CMTI) pour otocoupleurs	99
9	Méth	odes d'e	essai des caractéristiques électriques pour le coupleur phototriac	101
	9.1	Tensio	n de crête répétitive à l'état bloqué (V <sub>DRM</sub> )	101
	9.2	Tensio	n continue dans l'état bloqué V <sub>BD</sub>	102
Anı	nexe A	A (norma	ative) Essais de sécurité entrée/sortie	103
Bib	liogra	phie		104

Figure 1a – Intervalles de temps pour la méthode a)	66
Figure 1b – Intervalles de temps pour la méthode b)	67
Figure 1 – Intervalles de temps de la tension d'essai	67
Figure 2 – Tension d'essai	69
Figure 3 – Circuit de mesure	79
Figure 4 – Circuit de mesure pour capacité entrée-sortie	81
Figure 5 – Circuit de mesure pour la résistance d'isolement	81
Figure 6 – Circuit d'essai pour la tenue de contrainte de la tension d'isolement	82
Figure 7 – Circuit d'essai de décharge partielle	83
Figure 8 – Connexions pour l'étalonnage du circuit d'essai complet	84
Figure 9 – Circuit de mesure en courant continu	86
Figure 10 – Circuit de mesure en impulsion	87
Figure 11 – Circuit de mesure des temps de commutation	88
Figure 12 – Temps de commutation	89
Figure 13 – Circuit de mesure pour courant de crête à l'état bloque	90
Figure 14 – Formes d'ondes de la tension et du courant de crête à l'état bloqué	91
Figure 15 – Circuit de mesure pour tension de crête à l'état passant	92
Figure 16 - Formes d'ondes de la tension et du courant de crête à l'état passant	93
Figure 17 – Circuit de mesure pour courant continu à l'état blogué	93
Figure 18 – Circuit de mesure pour tension continue à l'état passant	94
Figure 19 – Circuit de mesure pour courant de maintien	95
Figure 20 – Circuit de mesure pour le taux critique d'augmentation de la tension à l'état bloqué	96
Figure 21 – Forme d'onde exponentielle de la tension de blocage ( $V_{\rm D}$ )	97
Figure 22 – Forme d'onde linéaire de la tension de blocage (VD)	97
Figure 23 – Circuit de mesure pour le courant d'entrée d'amorçage	98
Figure 24 – Tension aux bornes de sortie par rapport au courant direct d'entrée	98
Figure 25 – Circuit de mesure de l'immunité transitoire en mode commun (CMTI) pour les optocoupleurs	99
Figure 26 – Formes d'ondes typiques de l'impulsion en mode commun ( $V_{CM}$ ) et sortie de l'optocoupleur ( $V_O$ )	101
Figure A.1 – Schema de circuit	103
Tableau 1 – Caractéristiques techniques	72
Tableau 2 – Essais et séquence d'essai pour photocoupleur de protection contre les	
chocs électriques	78
Tableau 3 – Conditions d'essai	78

- 58 -

60747-5-5 © CEI:2007+A1:2013

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS DISCRETS –

### Partie 5-5: Dispositifs optoélectroniques – Photocoupleurs

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI colabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions tixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étart donne que les Comitée nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comites nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de donanges corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications références est obligatoile pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attrée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

# Cette version consolidée de la CEI 60747-5-5 comprend la première édition (2007) [documents 47E/332/FDIS et 47E/340/RVD] et son amendement 1 (2013) [documents 47E/437/CDV et 47E/451/RVC]. Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par l'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les suppressions sont barrées.

La Norme internationale CEI 60747-5-5 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme remplace les articles pour les photocoupleurs (ou optocoupleurs) décrites dans la CEI 60747-5-1, la CEI 60747-5-2 et la CEI 60747-5-3, y compris leurs amendements.

Le texte concernant les phototransistors et les photothyristors dans la CEI 60747-5-1, la CEI 60747- 5-2 et la CEI 60747-5-3 y compris leurs amendements sera considéré obsolète à la date effective de publication de la présente norme.

NOTE Les photocoupleurs qui sont certifiés selon la version précédente de la norme sur les photocoupleurs, c'est-à-dire la CEI 60747-5-1/2/3, sont à considérer comme étant en conformité avec les exigences et dispositions de la CEI 60747-5-5.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60747, présentée sous le titre général *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

- 60 -

60747-5-5 © CEI:2007+A1:2013

### DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS DISCRETS –

### Partie 5-5: Dispositifs optoélectroniques – Photocoupleurs

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60747 donne la terminologie, les performances essentielles, les caractéristiques, les essais de sécurité ainsi que les méthodes de mesures pour les photocoupleurs (ou optocoupleurs).

NOTE Le terme « optocoupleur » peut aussi être employé à la place de «photocoupleur».

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60065:2001, Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide

CEI 60068-2-1:2007, Essais d'environnement - Partie 2: Essais - Essais A: Froid

CEI 60068-2-2:2007, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai B: Chaleur sèche

CEI 60068-2-78;2001, Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu

CEI 60068-2-6:—, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales) <sup>1</sup>

CEI 60068-2-14:1984, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai N: Variations de température

CEI 60068-2-17:1994, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Q: Etanchéité

CEI 60068-2-27:—, Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs <sup>2</sup>

CEI 60068-2-30:2005, Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)

CEI 60068-2-58:2005, Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

CEI 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A publier (remplaçant la sixième édition)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A publier (remplaçant la troisième édition)

CEI 60216-1:2001, Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai

CEI 60216-2:2005, Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 2: Détermination des propriétés d'endurance thermique de matériaux isolants électriques – Choix de critères d'essai

CEI 60664-1:2007, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais

CEI 60672-2:1999, Matériaux isolants à base de céramique ou de verre – Partie 2: Méthodes d'essai

CEI 60695-11-5:2004, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices